

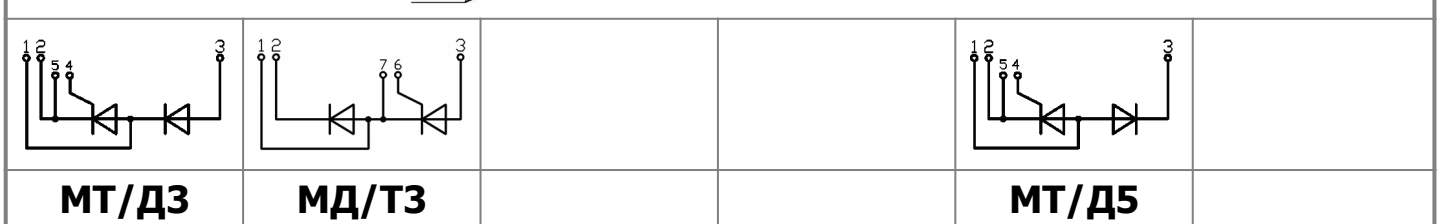
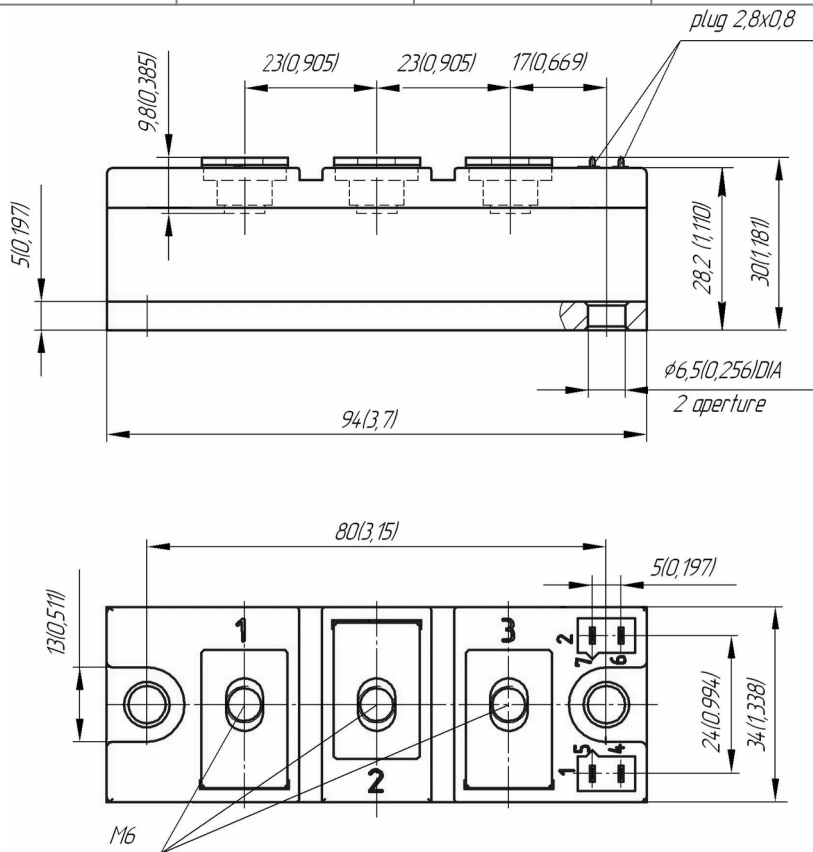
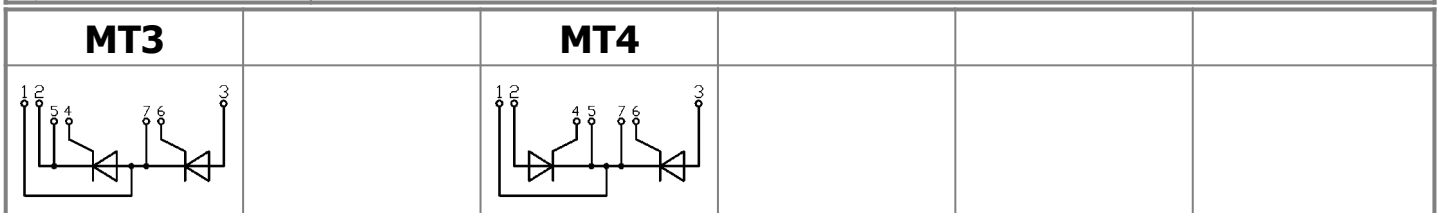


ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС

Изолированное основание
 Корпус промышленного стандарта
 Упрощенная механическая конструкция,
 быстрая сборка
 Прижимная конструкция

Двухпозиционный Тиристорный Модуль МТх-125-28-Ф

Средний прямой ток	I_{TAV}	125 A		
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	2400...2800 В		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}			
Время выключения	t_q	250 мкс		
$U_{DRM}, U_{RRM}, В$	2400	2600	2800	
Класс по напряжению	24	26	28	
$T_j, ^\circ C$	-40...+125			





ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	A	125 148	$T_c = 92\text{ }^\circ\text{C};$ $T_c = 85\text{ }^\circ\text{C};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	A	196	$T_c = 92\text{ }^\circ\text{C};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	кА	3.8 4.5	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 10\text{ мс};$ единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В};$ Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}; t_{GP} = 50\text{ мкс};$ $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
			4.0 4.5	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 8.3\text{ мс};$ единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В};$ Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}; t_{GP} = 50\text{ мкс};$ $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
I^2t	Защитный показатель	$A^2c \cdot 10^3$	70 100	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 10\text{ мс};$ единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В};$ Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}; t_{GP} = 50\text{ мкс};$ $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
			60 80	$T_j = T_{j\max}$ $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$	180 эл. град. синус; $t_p = 8.3\text{ мс};$ единичный импульс; $U_D = U_R = 0\text{ В};$ Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}; t_{GP} = 50\text{ мкс};$ $di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$
Блокирующие параметры					
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	B	2400...2800	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max};$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто	
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	B	2500...2900	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max};$ 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто	
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	B	$0.6 \cdot U_{DRM}$ $0.6 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max};$ управление разомкнуто	
Параметры управления					
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	A	5	$T_j = T_{j\max}$	
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	B	5		
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	3	$T_j = T_{j\max}$ для постоянного тока управления	
Параметры переключения					
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f = 1\text{ Hz}$)	A/мкс	800	$T_j = T_{j\max}; U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}; I_{TM} = 840\text{ А};$ Импульс управления: $I_G = 2\text{ А}; U_G = 20\text{ В};$ $t_{GP} = 50\text{ мкс}; di_G/dt = 2\text{ А/мкс}$	
Тепловые параметры					
T_{stg}	Температура хранения	$^\circ\text{C}$	-40...+50		
T_j	Температура р-п перехода	$^\circ\text{C}$	-40...+125		
$T_{c\text{оп}}$	Рабочая температура корпуса	$^\circ\text{C}$	-40...+125		
Механические параметры					
a	Ускорение	м/с^2	50		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения		
Характеристики в проводящем состоянии						
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	1.80	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}; I_{TM}=500\text{ A}$		
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.246	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$		
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.915			
I_L	Ток включения, макс	мА	500	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}; U_D=12\text{ В};$ Импульс управления: $I_G=2\text{ A};$ $t_{GP}=50\text{ мкс}; di_G/dt \geq 1\text{ А/мкс}$		
I_H	Ток удержания, макс	мА	250	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C};$ $U_D=12\text{ В};$ управление разомкнуто		
Блокирующие характеристики						
I_{DRM}, I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	40 2.50	$T_j=T_{j\text{ max}}$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	$U_D=U_{DRM}; U_R=U_{RRM}$	
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии ¹⁾ , мин	В/мкс	200, 320, 500, 1000, 1600, 2000, 2500	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$ управление разомкнуто		
Характеристики управления						
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	3.00 2.50 1.50	$T_j= T_{j\text{ min}}$ $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_j= T_{j\text{ max}}$	$U_D=12\text{ В}; I_D=3\text{ А};$ Постоянный ток управления	
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	400 250 150	$T_j= T_{j\text{ min}}$ $T_j= 25\text{ }^\circ\text{C}$ $T_j= T_{j\text{ max}}$		
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.45	$T_j=T_{j\text{ max}};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM};$ Постоянный ток управления		
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	35.00			
Динамические характеристики						
t_{gd}	Время задержки, макс	мкс	0.90	$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}; U_D=1500\text{ В}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di/dt=200\text{ А/мкс};$		
t_{gt}	Время включения, макс	мкс	3.00	Импульс управления: $I_G=2\text{ А}; U_G=20\text{ В};$ $t_{GP}=50\text{ мкс}; di_G/dt=2\text{ А/мкс}$		
t_q	Время выключения ²⁾ , макс	мкс	250	$du_D/dt=50\text{ В/мкс}; T_j=T_{j\text{ max}}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di_R/dt=-10\text{ А/мкс}; U_R=100\text{ В};$ $U_D=0.67 \cdot U_{DRM}$		
Q_{rr}	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	1080	$T_j=T_{j\text{ max}}; I_{TM}=I_{TAV};$ $di_R/dt=-10\text{ А/мкс};$ $U_R=100\text{ В}$		
t_{rr}	Время обратного восстановления, макс	мкс	24			
I_{rr}	Обратный ток восстановления, макс	А	90			
Тепловые характеристики						
R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс			180 эл. град. синус; 50 Гц		
		на модуль	$^\circ\text{C/Вт}$			0.0850
		на позицию	$^\circ\text{C/Вт}$			0.1700
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс			Постоянный ток		
		на модуль	$^\circ\text{C/Вт}$			0.0300
		на позицию	$^\circ\text{C/Вт}$			0.0600

Характеристики изоляции					
U _{ISOL}	Электрическая прочность изоляции	кВ	3.00	синус; 50 Гц; действующее значение	t=60 с
			3.60		t=1 с
Механические характеристики					
M ₁	Момент затяжки основания (M6) ³⁾	Нм	6.00	Допуск ± 15%	
M ₂	Момент затяжки выводов (M6) ³⁾	Нм	6.00	Допуск ± 15%	
m	Масса, макс	г	350		

МАРКИРОВКА										ПРИМЕЧАНИЕ																										
MT	3	-	125	-	28	-	A2	M2	-	F	-	Y2	¹⁾ Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии																							
1	2		3		4		5	6		7		8																								
1. Тиристорный модуль (MT) Тиристорно-диодный модуль (MT/Д) Диодно-тиристорный модуль (МД/Т) 2. Схема включения 3. Средний прямой ток, А 4. Класс по напряжению 5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии 6. Группа по времени выключения (du _D /dt=50 В/мкс) 7. Тип корпуса (M.F) 8. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: Y2													<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th><th>P2</th><th>K2</th><th>E2</th><th>A2</th><th>T1</th><th>P1</th><th>M1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(du_D/dt)_{crit}, В/мкс</td><td>200</td><td>320</td><td>500</td><td>1000</td><td>1600</td><td>2000</td><td>2500</td></tr> </tbody> </table>								Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1	(du _D /dt) _{crit} , В/мкс	200	320	500	1000	1600	2000	2500
Обозначение группы	P2	K2	E2	A2	T1	P1	M1																													
(du _D /dt) _{crit} , В/мкс	200	320	500	1000	1600	2000	2500																													
													²⁾ Время выключения (du _D /dt=50 В/мкс)																							
													<table border="1"> <thead> <tr> <th>Обозначение группы</th><th>M2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>t_d, мкс</td><td>250</td></tr> </tbody> </table>								Обозначение группы	M2	t _d , мкс	250												
Обозначение группы	M2																																			
t _d , мкс	250																																			
													³⁾ Резьба должна быть смазана																							
													Сертифицирован UL, файл № E255404																							

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав. В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.

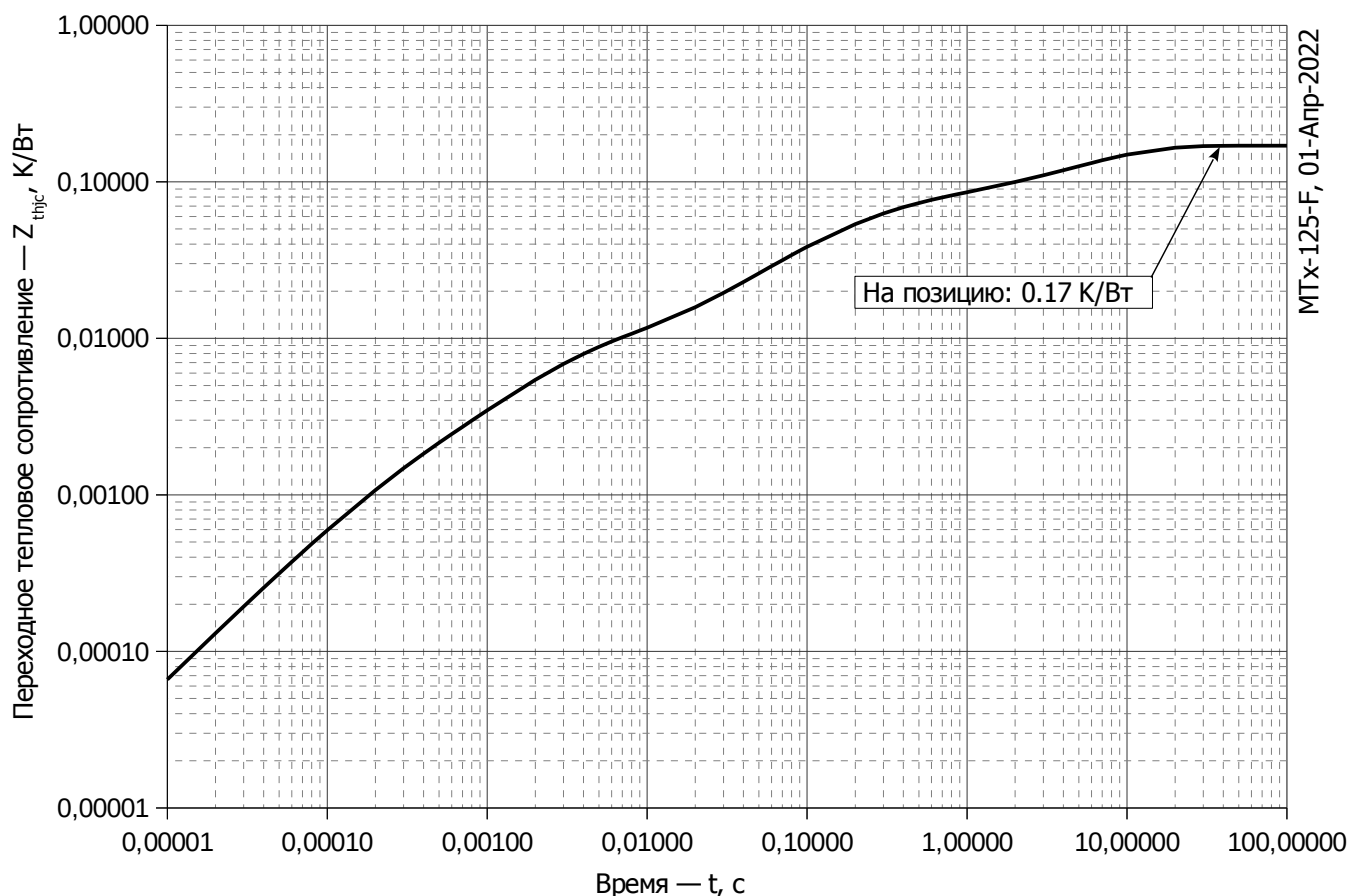


Рис. 1 – Зависимость переходного теплового сопротивления Z_{thjc} от времени t

Аналитическая зависимость переходного теплового сопротивления переход — корпус:

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^n R_i \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_i}} \right)$$

Где $i = 1$ to n , n – число суммирующихся элементов.

t = продолжительность импульсного нагрева в секундах.

Z_{thjc} = Тепловое сопротивление за время t .

R_i, τ_i = расчетные коэффициенты, приведенные в таблице.

i	1	2	3	4	5	6
$R_i, \text{K/W}$	0.0007228424	0.0066399867	0.0153862565	0.0389709604	0.0142906115	0.09398934
τ_i, c	0.0002111	0.002366	0.06905	0.1909	0.6646	6.64

Модель переходного теплового сопротивления переход - корпус (см. Рис. 1)

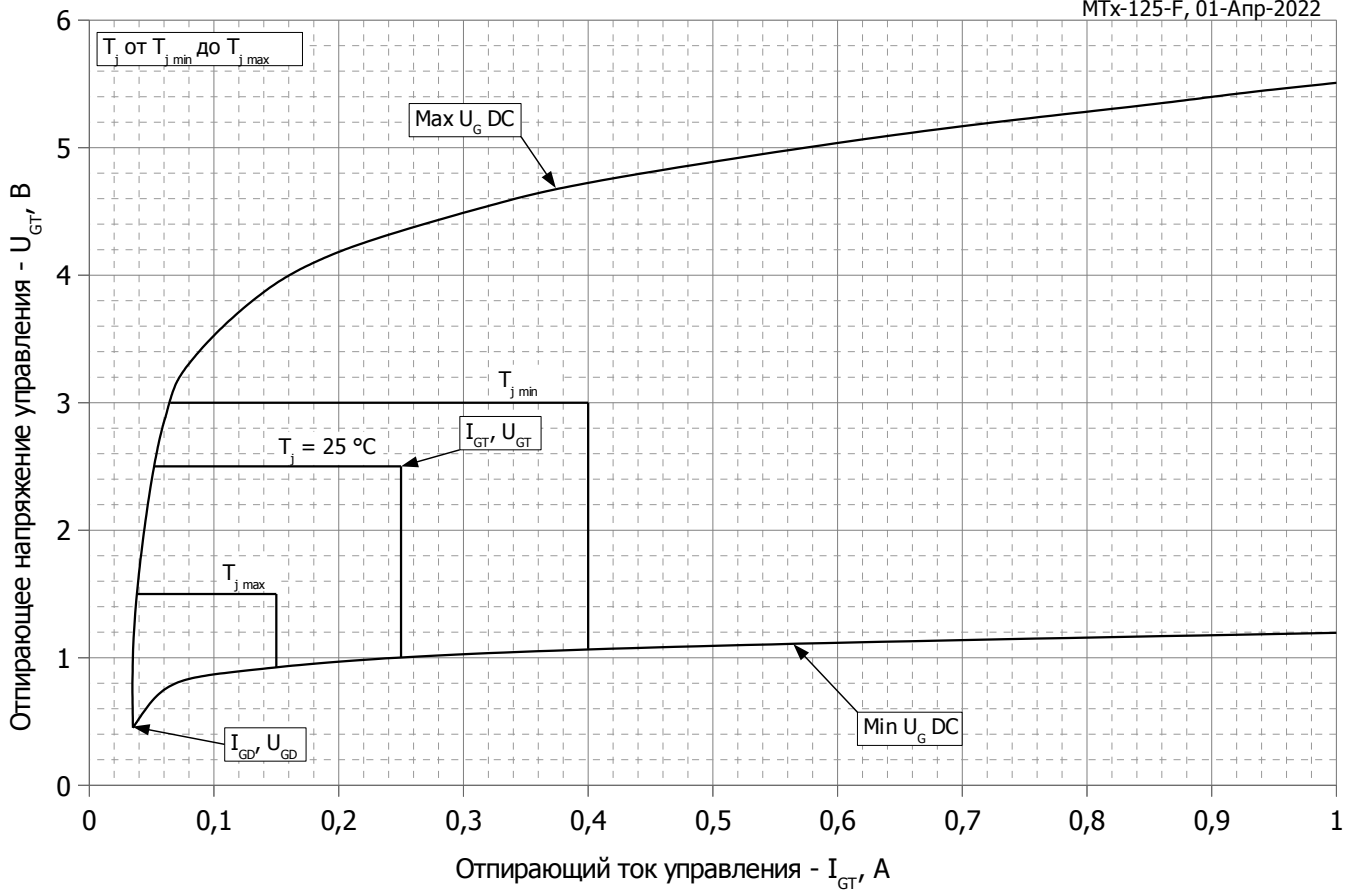


Рис. 2 – Вольт – амперная характеристика цепи управления

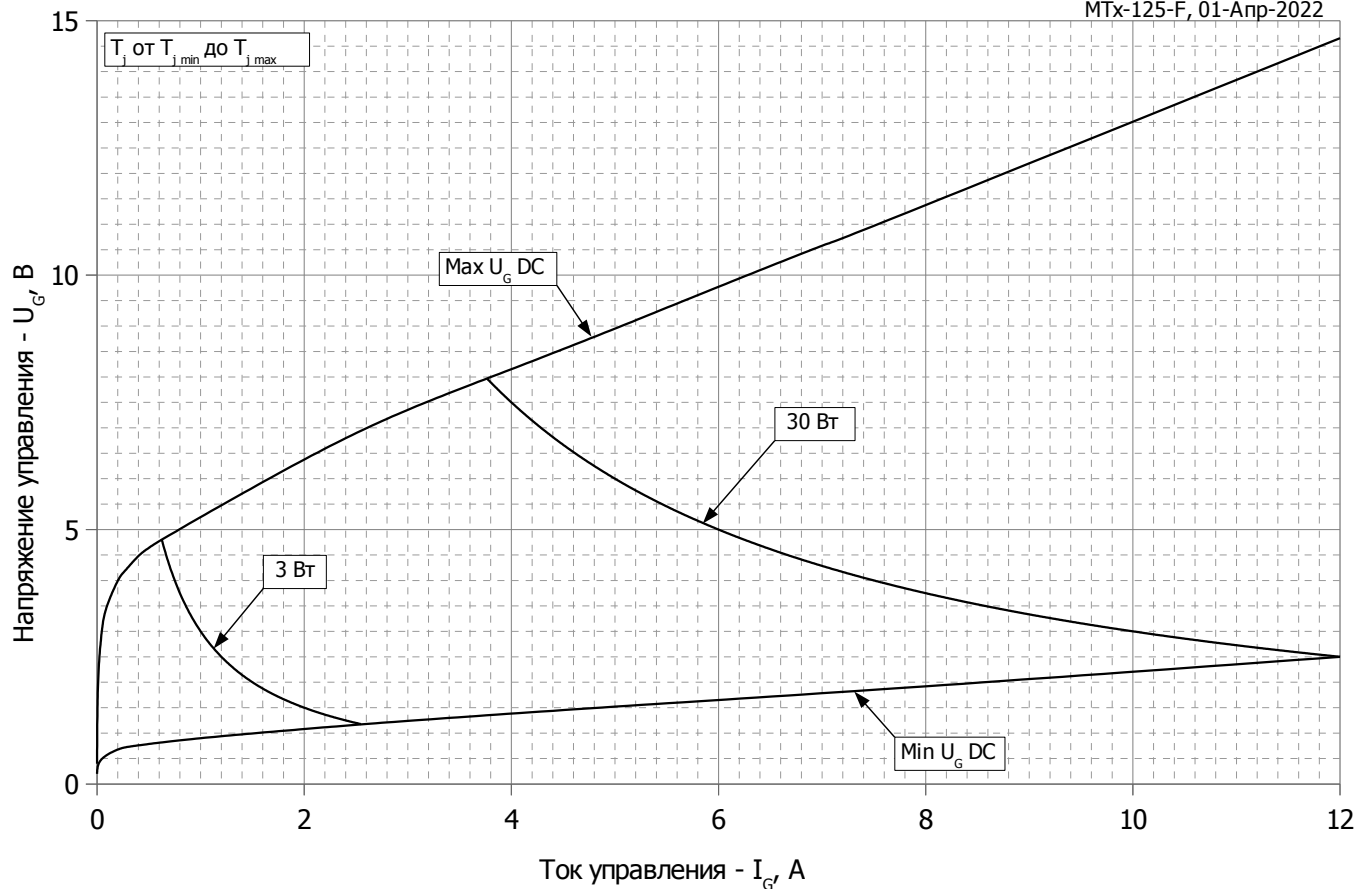


Рис. 3 – Вольт – амперная характеристика цепи управления — Кривые мощности

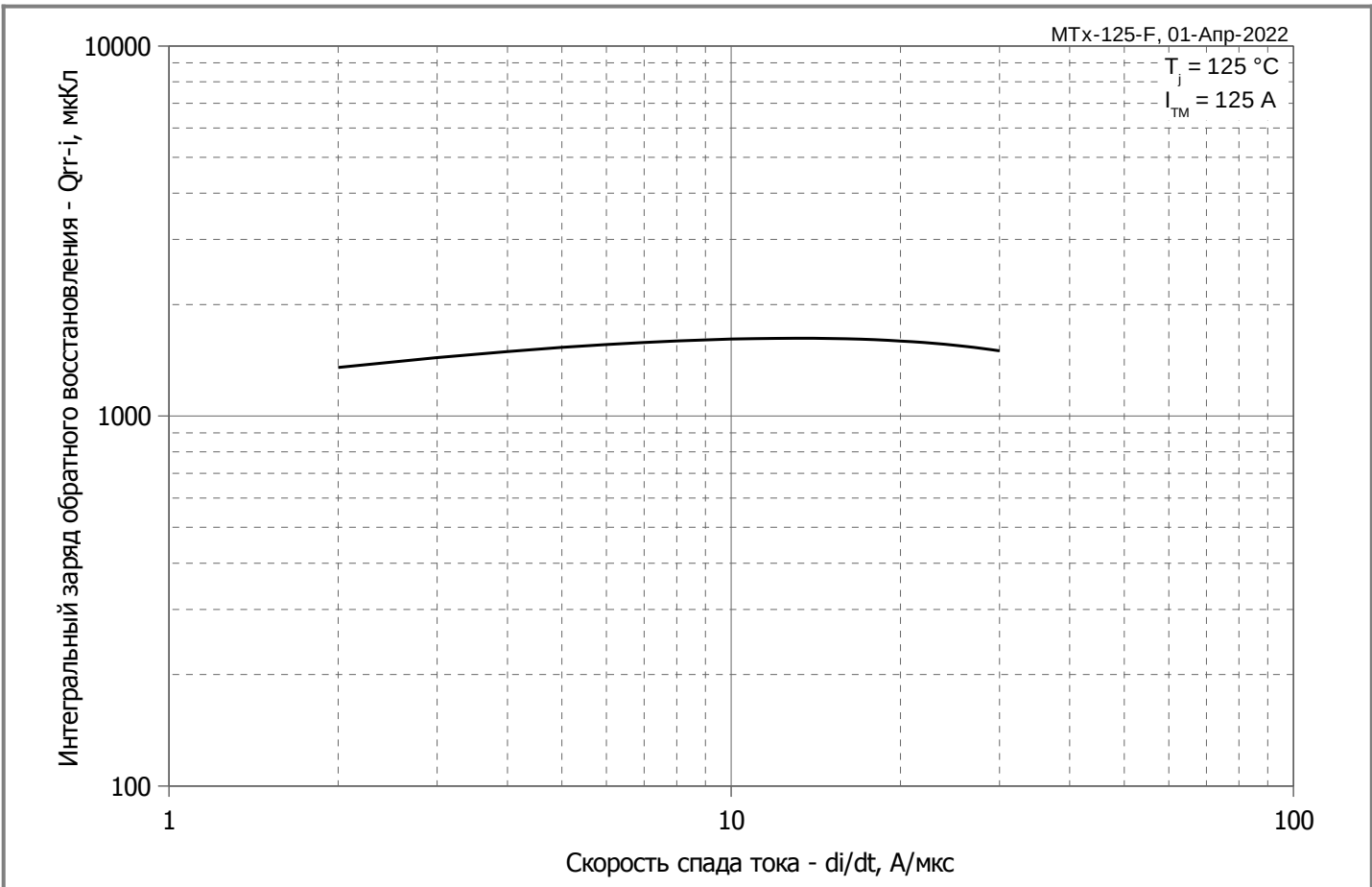


Рис. 4 – Зависимость максимального интегрального заряда обратного восстановления Q_{gr-i} от скорости спада тока di_R/dt в открытом состоянии

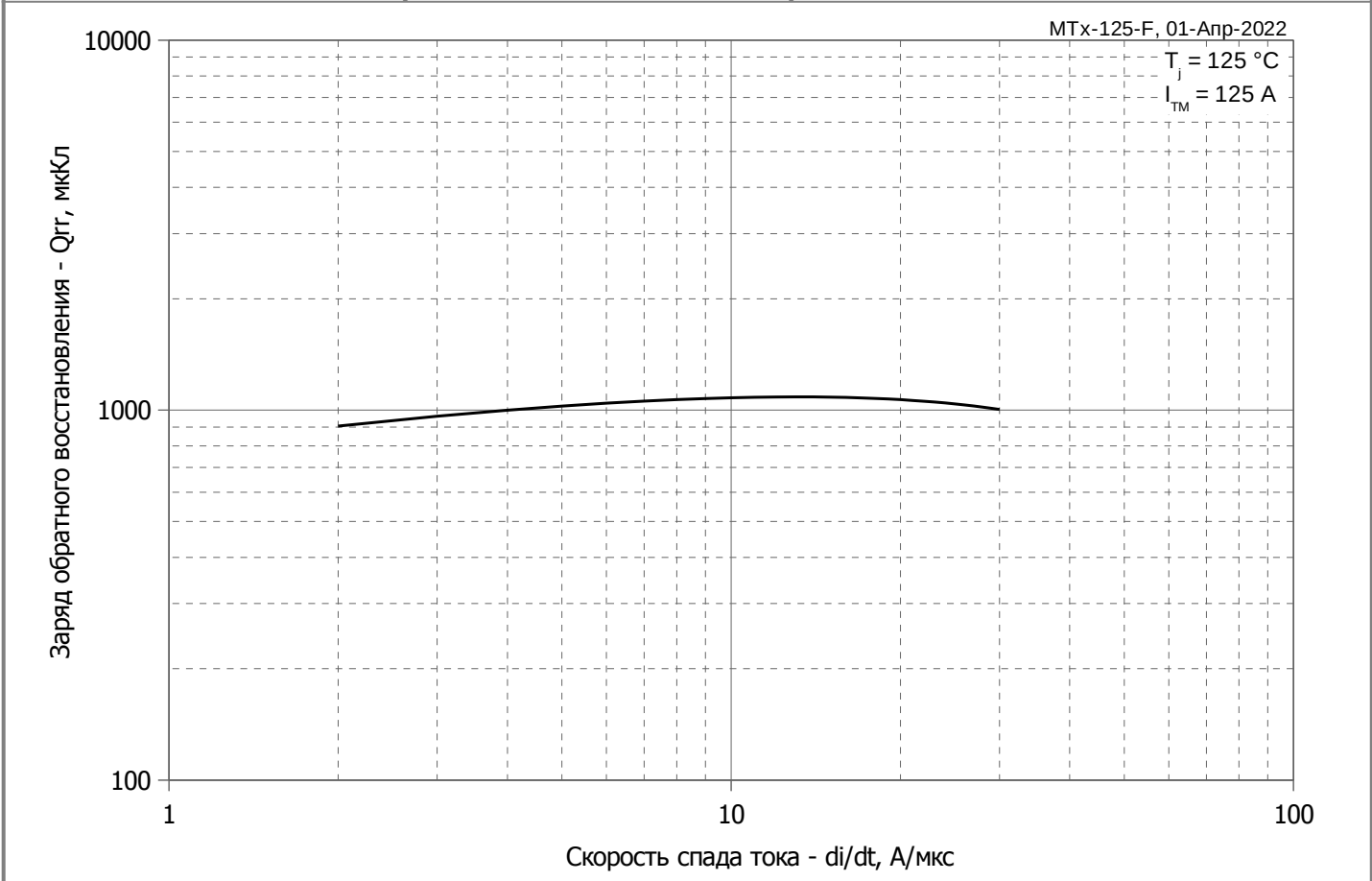


Рис. 5 – Зависимость максимального заряда обратного восстановления Q_{gr} от скорости спада тока di_R/dt (по ГОСТ 24461, хорда 25%) в открытом состоянии

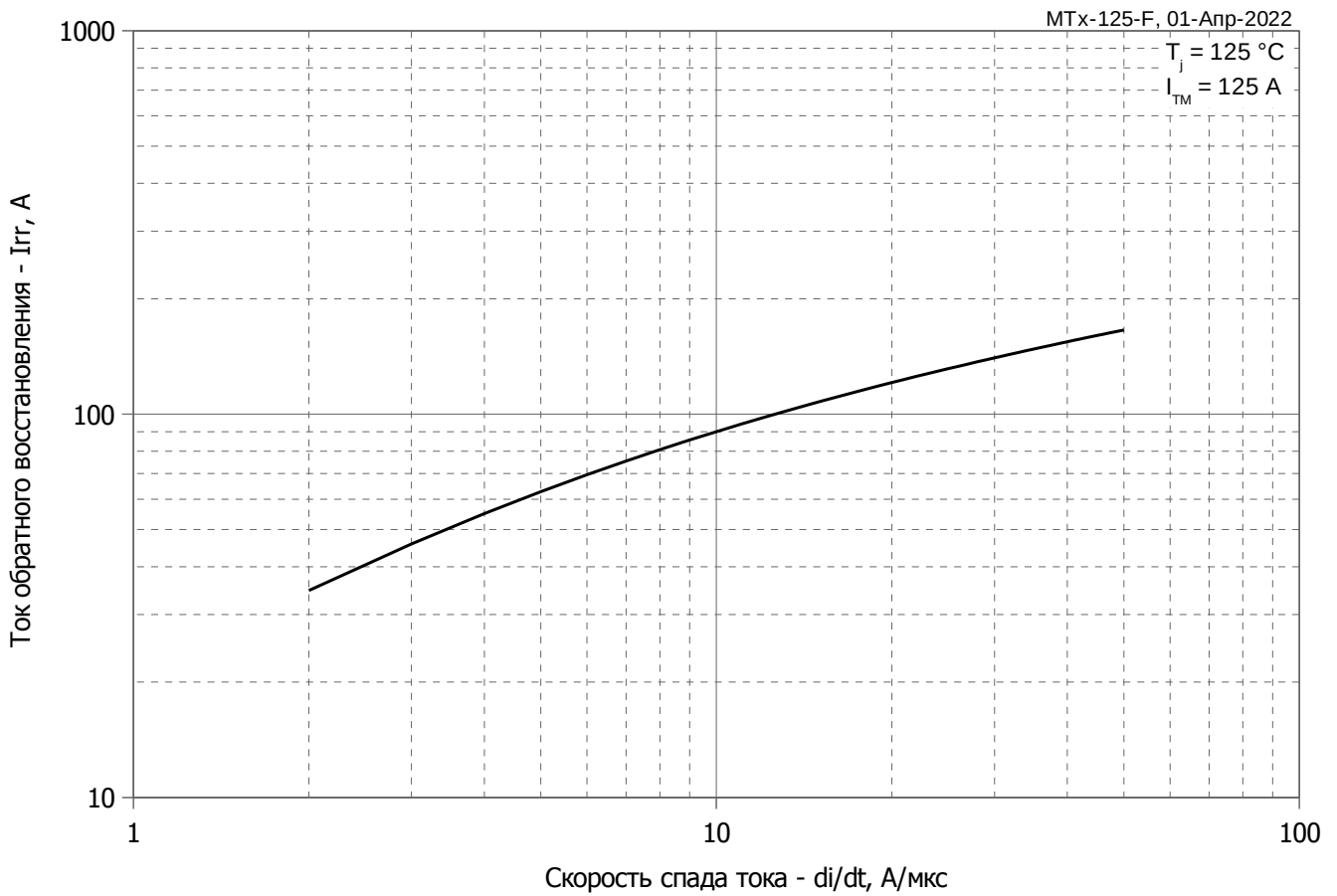


Рис. 6 – Зависимость максимального обратного тока восстановления I_{rr} от скорости спада тока di_R/dt в открытом состоянии

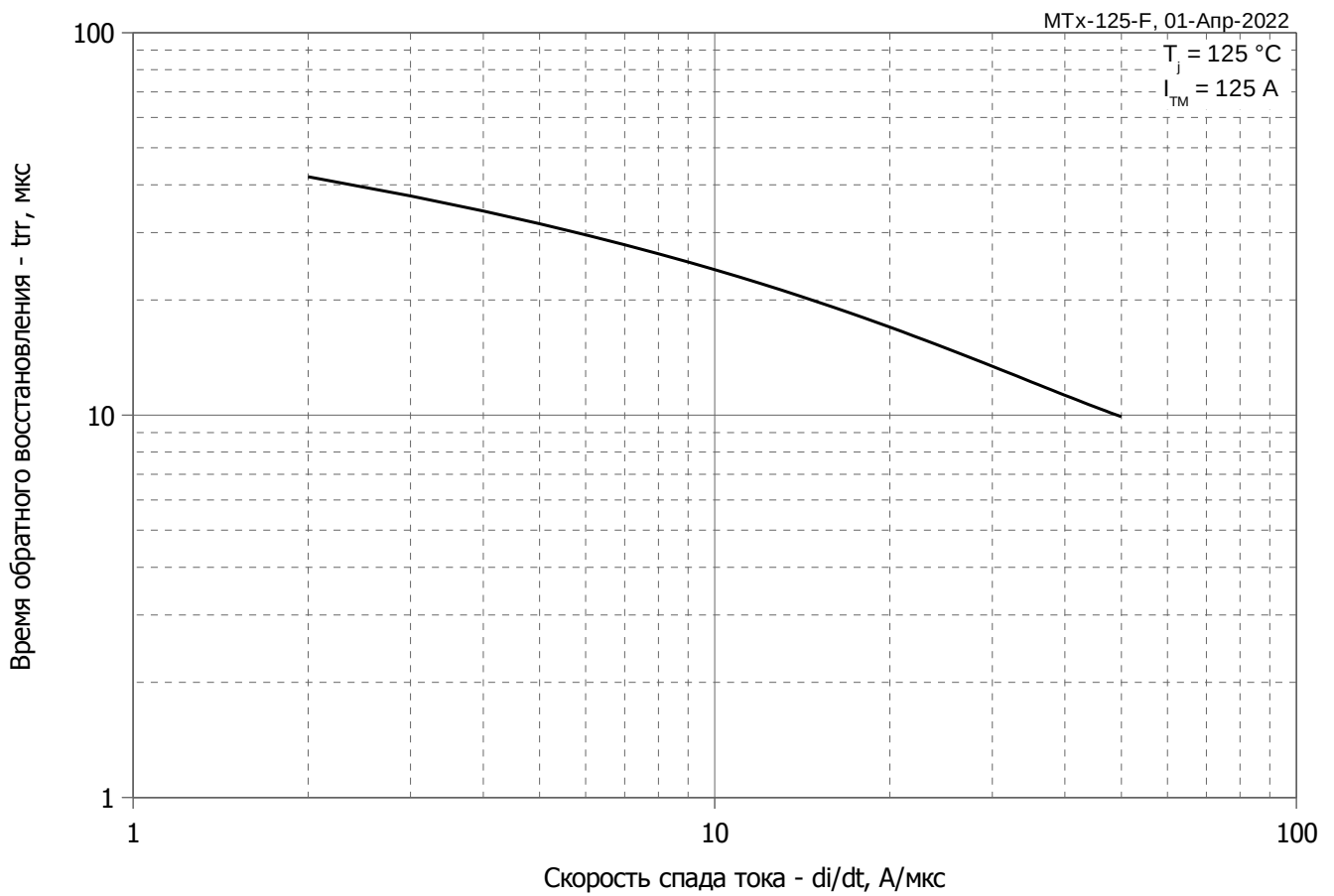


Рис. 7 - Зависимость максимального времени обратного восстановления t_{rr} от скорости спада тока di_R/dt (по ГОСТ 24461, хорда 25%) в открытом состоянии

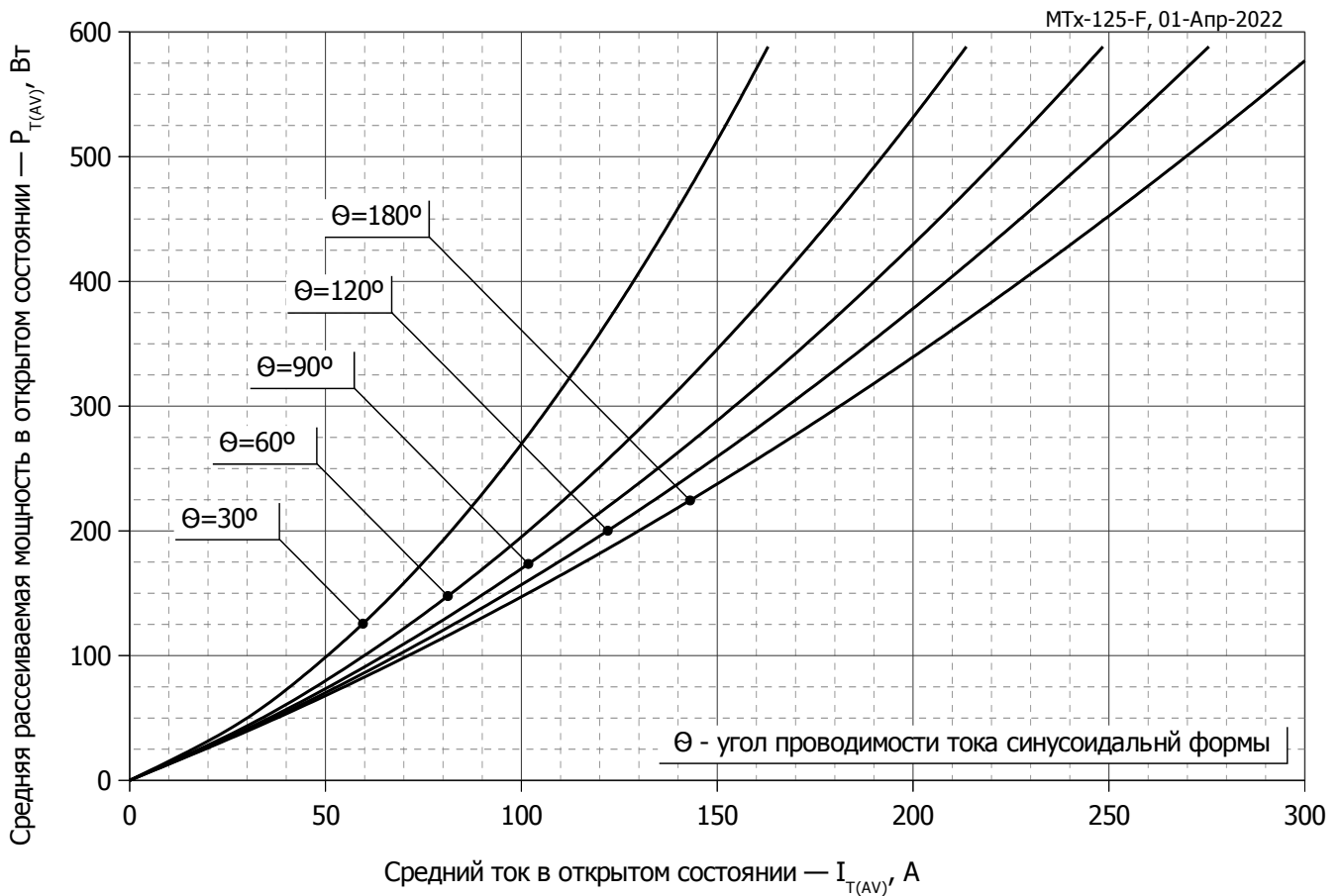


Рис. 8 - Зависимость потерь мощности P_{TAV} от среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} синусоидальной формы при различных углах проводимости ($f=50$ Гц)

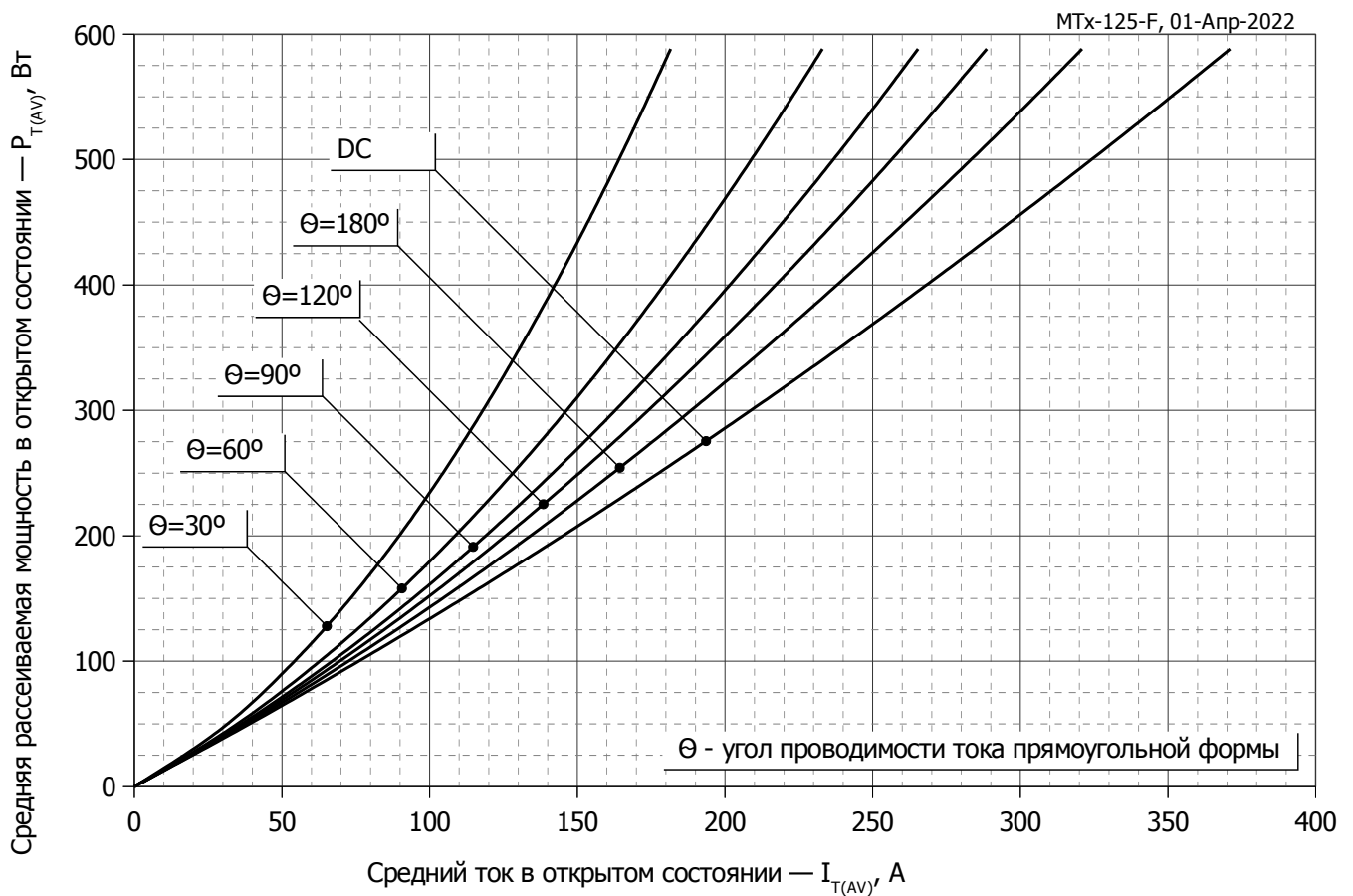


Рис. 9 – Зависимость потерь мощности P_{TAV} от среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} прямоугольной формы при различных углах проводимости ($f=50$ Гц)

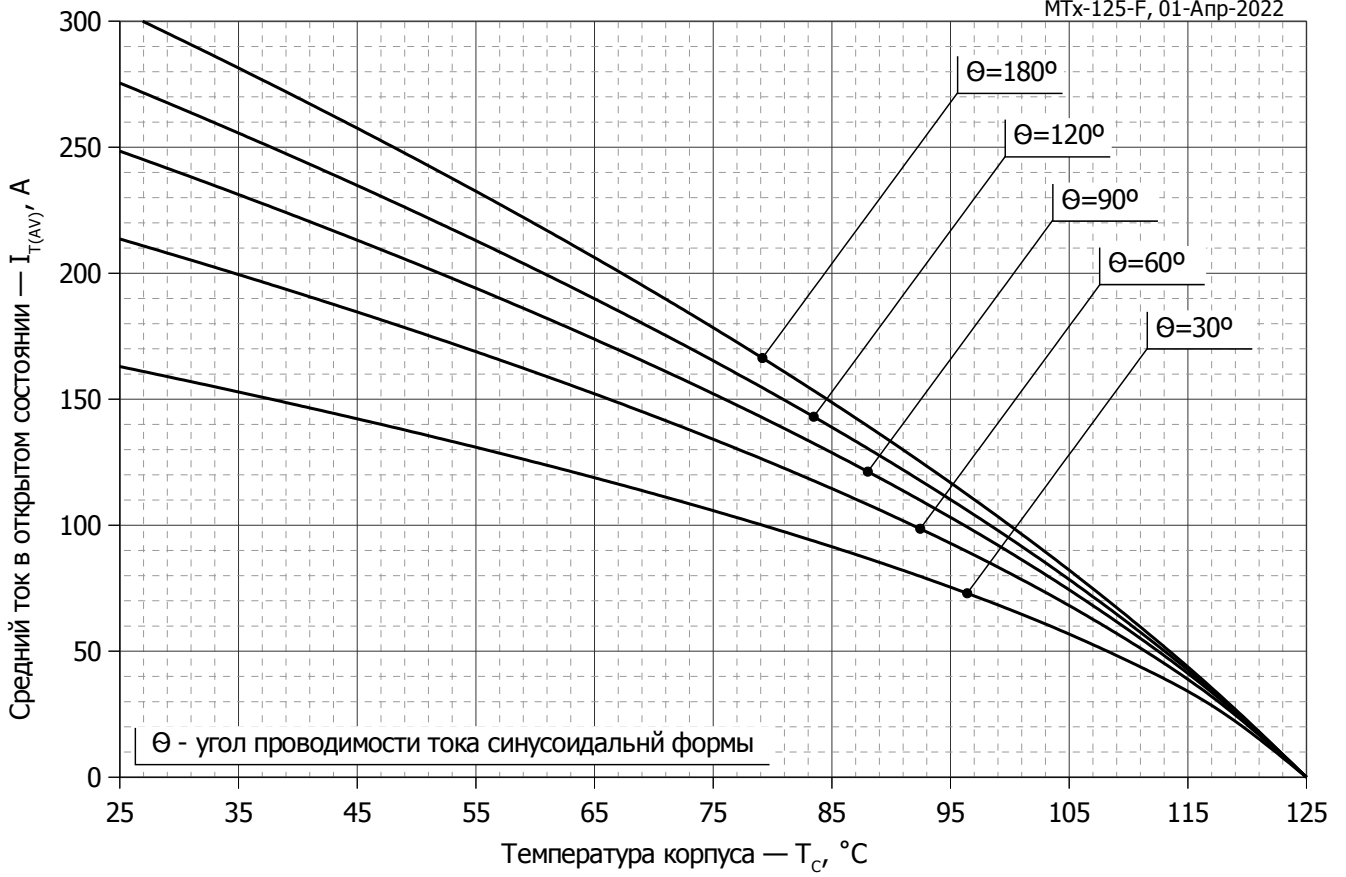


Рис. 10 – Зависимость среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} от температуры корпуса T_C для синусоидальной формы тока при различных углах проводимости ($f=50$ Гц)

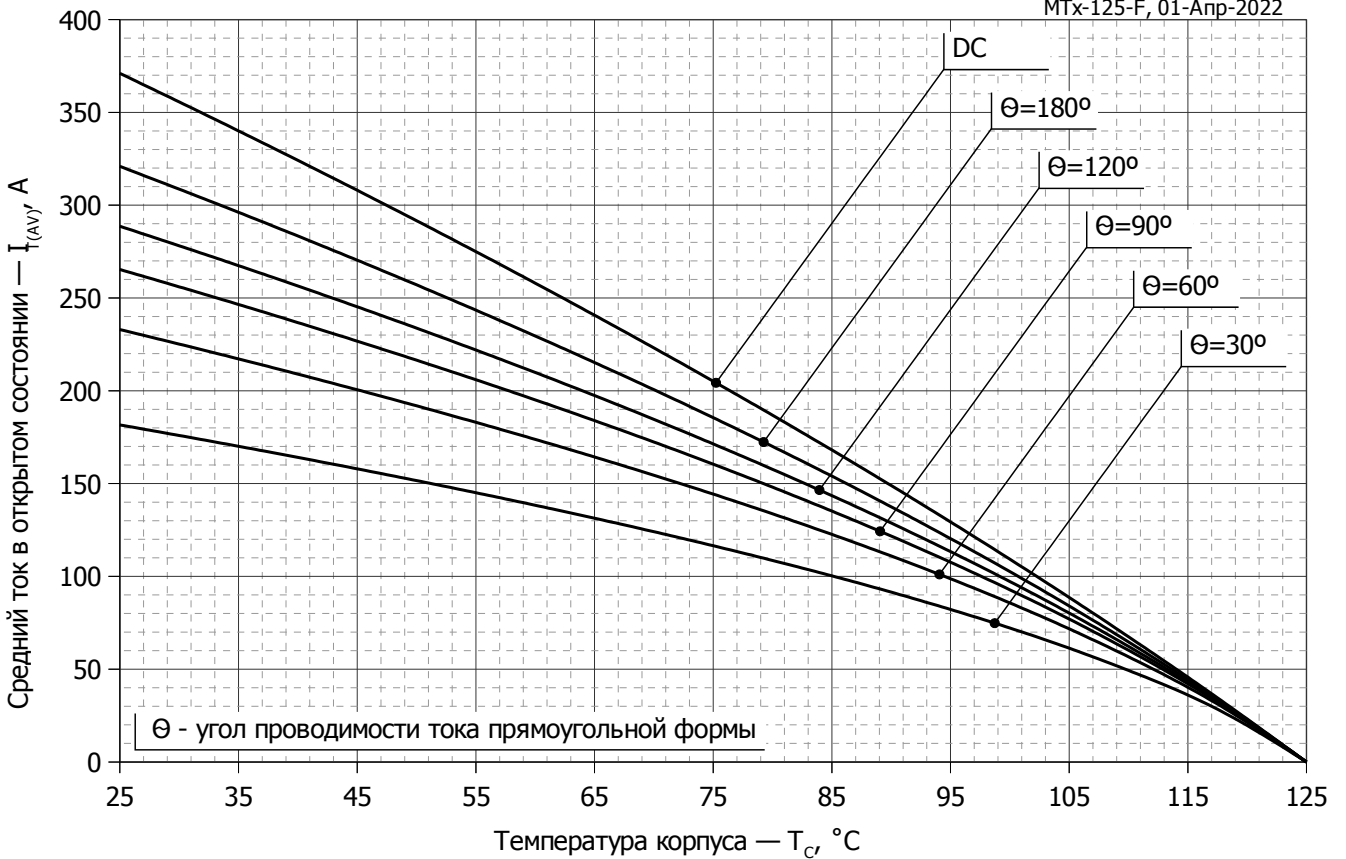


Рис. 11 - Зависимость среднего тока в открытом состоянии I_{TAV} от температуры корпуса T_C для прямоугольной формы тока при различных углах проводимости ($f=50$ Гц)

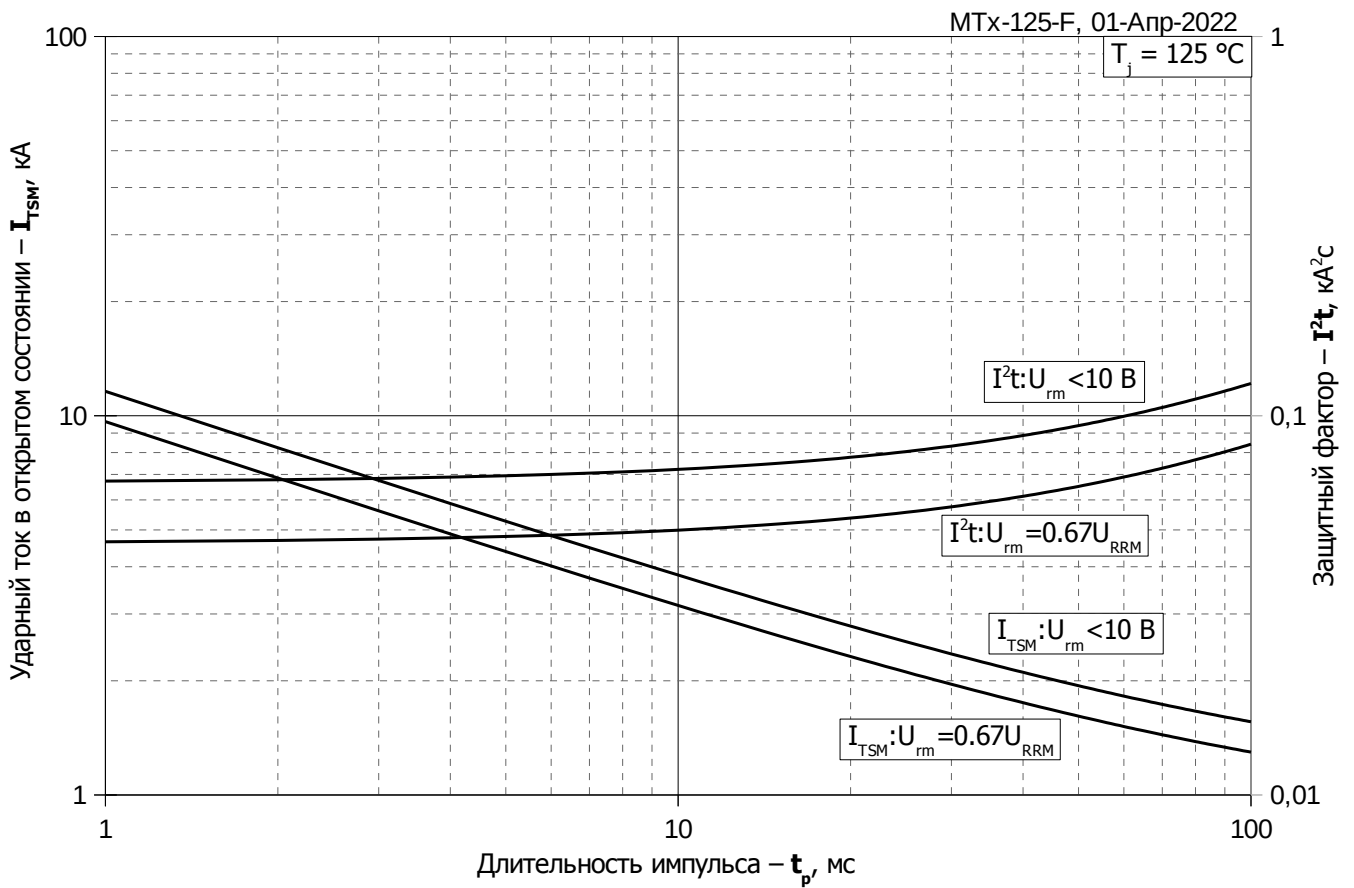


Рис. 12 – Зависимость максимальной амплитуды ударного тока в открытом состоянии I_{TSM} и защитного фактора I^2t от длительности импульса t_p

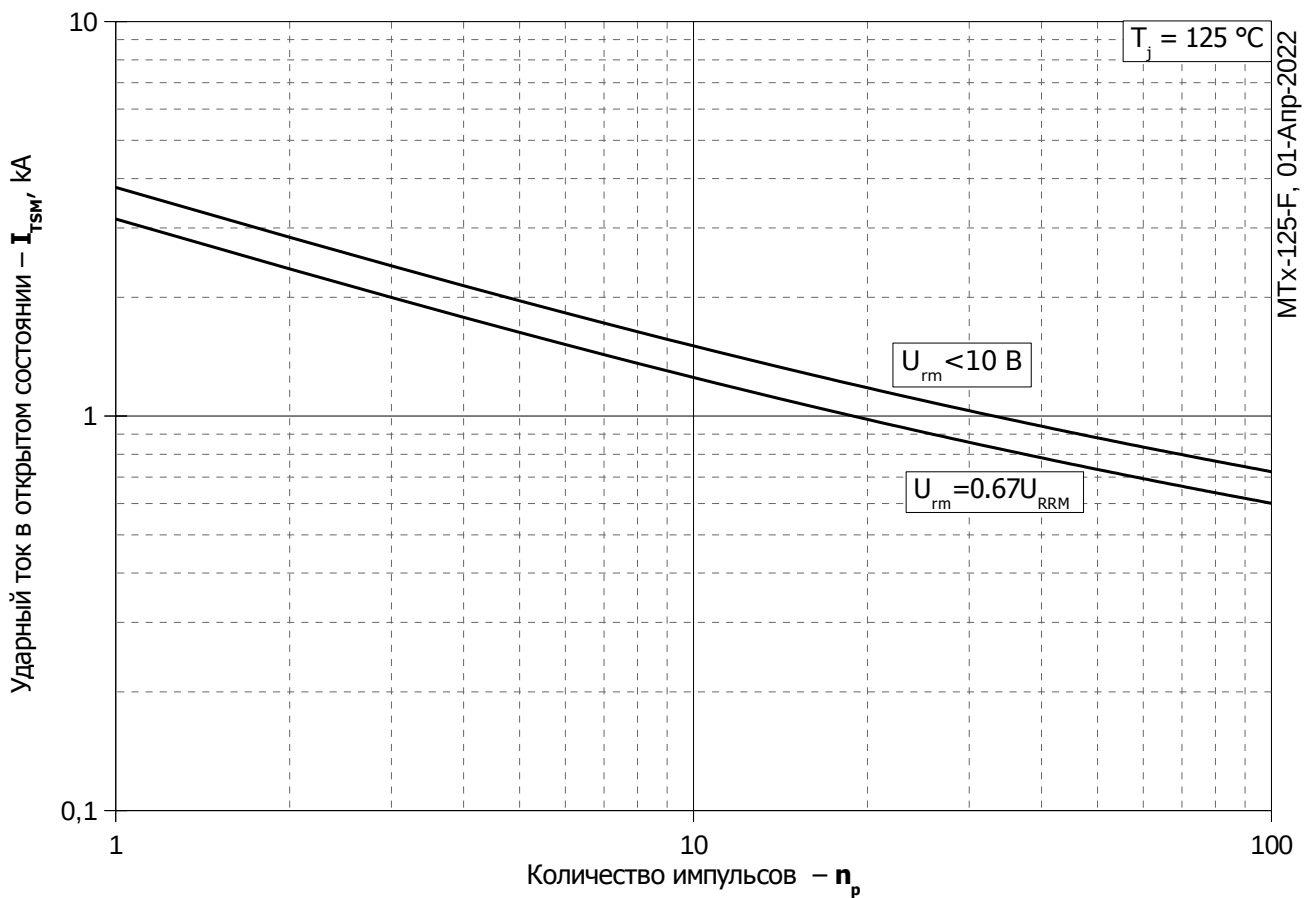


Рис. 13 – Зависимость максимальной амплитуды ударного тока в открытом состоянии I_{TSM} от количества импульсов n_p